

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年7月26日(2012.7.26)

【公開番号】特開2011-222805(P2011-222805A)

【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2011-044

【出願番号】特願2010-91291(P2010-91291)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/14 (2006.01)

H 0 1 L 25/07 (2006.01)

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/14 R

H 0 1 L 25/04 C

【手続補正書】

【提出日】平成24年6月8日(2012.6.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

以上説明したように、本実施の形態では、低誘電率膜 19 が半田 16 と下面電極 15 の側面を覆い、低誘電率膜 20 が半田 17 と半導体チップ 18 の側面を覆っている。これにより、半田 17 からの気泡発生を抑制することができる。よって、絶縁不良を低減することができ、製品の長寿命化が可能となる。